

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第7部門第3区分  
 【発行日】平成19年4月19日(2007.4.19)

【公開番号】特開2005-102148(P2005-102148A)  
 【公開日】平成17年4月14日(2005.4.14)  
 【年通号数】公開・登録公報2005-015  
 【出願番号】特願2004-187412(P2004-187412)  
 【国際特許分類】

**H 0 3 B 5/04 (2006.01)**

**H 0 3 B 5/12 (2006.01)**

**H 0 4 B 1/26 (2006.01)**

【F I】

H 0 3 B 5/04 B

H 0 3 B 5/04 C

H 0 3 B 5/12 B

H 0 4 B 1/26 U

【手続補正書】

【提出日】平成19年3月2日(2007.3.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

【特許文献1】特開2001-156545号公報(図3)

【非特許文献1】シマ ディミトリジェブ(Sima Dimitrijevic)著、「アンダースタンディング・セミコンダクタ・デバイスズ(Understanding Semiconductor Devices)」、オクスフォード・ユニバーシティ・プレス(Oxford University Press)2000年、p.168-170

【非特許文献2】アレン アンド ホルバーグ(Allen and Holberg)著、「CMOSアナログサーキットデザイン(CMOS Analog Circuit Design)」、オクスフォード・ユニバーシティ・プレス(Oxford University Press)1987年、p.124-127

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

前述した帰還用のバッファ回路を容量結合で構成した容量帰還の場合は、容量として用いる金属配線や多結晶シリコン層は、基板との間に寄生容量を形成するため、配線寄生容量が増大する。したがって、LCの積を小さくする必要がある数ギガヘルツ以上の周波数を発生する電圧制御周波数発生器では、配線寄生容量が増大するために、バッファ回路の可変容量C1, C2を減少させる必要があり、そのため周波数可変範囲が狭くなるという問題がある。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0087

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0087】

温度特性変換回路5aは、NMOSトランジスタのゲート・ソース間電圧が持つ温度特性と、PMOSトランジスタのゲート・ソース間電圧が持つ温度特性が異なることを用いて、両者の温度特性の差を、入力端子101aに入力される入力電圧が持つ温度特性に加えて出力端子102aから出力する。

【手続補正4】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図14

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図14】

図14

